

講演予稿執筆・投稿要領

用紙(A4 版、1 枚)の上部 25mm、左右下部 20mm を余白にし、上から題目、所属・発表者、本文の順でご執筆ください。テンプレートをホームページからダウンロードしてご利用ください。予稿原稿は PDF ファイル(5MByte 以下)にて ion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛にご送付ください。

Proceedings(英文)執筆要領

A4 用紙の上下左右 30mm を余白にし、上から題目(大文字)、著者名、所属、アブストラクト(200 語まで、シングルスペース)、本文(シングルスペース)の順でご執筆ください。原稿は4または6 ページをご選択ください。オフセット印刷にて B5 版に縮刷されます。文献番号は本文中に上付き数字にて指示してください。また、参考文献は、本文の末尾にまとめ、番号、著者、Journal 名、巻(太文字)、ページ、発表年の順でご記載ください。

予稿原稿と同様に テンプレートをホームページからダウンロードしてご利用ください。完成原稿は PDF ファイルにて ion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛にご送付ください。

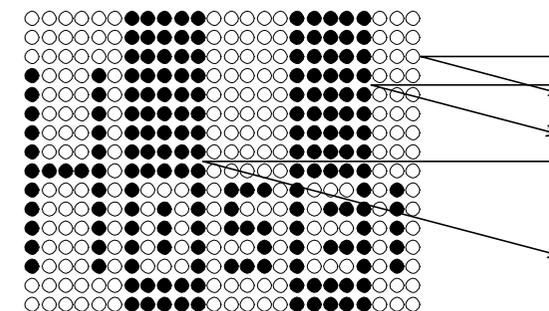
シンポジウム HP

<https://www.hosei.ac.jp/ionbeam/katsudo/>



第 39 回法政大学 イオンビーム工学研究所 シンポジウム

The 39th Symposium on
Materials Science and Engineering
Research Center of Ion Beam Technology
Hosei University



期日 2020 年 12 月 16 日 (水)
会場 オンライン開催
主催 法政大学イオンビーム工学研究所
協賛 日本物理学会
応用物理学会
日本アイソトープ協会 (順不同)

法政大学イオンビーム工学研究所は法政大学 100 周年を記念して設立されました。本シンポジウムは、1982 年に第 1 回を開催し、イオンビームの電子材料技術への応用、分析技術などの研究成果を討論する目的で開催してまいりました。

今年度のシンポジウムは「イオンビーム技術と関連材料技術」をテーマとしております。このイオンビームが広く利用されている分野での最先端の研究の話題や情報を提供していただき、活発な討論の場といたしたく、関連分野の研究者の方々に積極的に研究発表いただきますようご案内申し上げます。

今回は一般講演のみポスター発表をオンラインで実施いたします。使用するシステムは Remo を予定しております。

<https://remo.co>
詳細については下記 URL を参照ください。
<https://www.hosei.ac.jp/ionbeam/katsudo/>
また、シンポジウムで発表された論文は Proceedings(2020)として 2021 年 3 月に発行する予定です。

一般講演（ポスター発表）

下記のようなキーワードで一般講演を募集しますが、イオンビーム利用技術に限らず関連材料・技術に関する講演を広く募集します。

- 生体微量元素分析技術
- ナノパーティクル形成などナノテクノロジーへの応用
- ワイドバンドギャップ半導体のデバイス技術
- 半導体への不純物ドーピングおよび金属、絶縁物の表面改質
- 薄膜結晶、VLSI 用電極などの成膜技術
- プラズマプロセス、イオン源および分析技術などのイオンビーム工学関連技術

申込要領

- 「発表題目」「所属名」「発表者名（共同発表者名も）」を記載の上お申込みください。
- ホームページよりダウンロードした予稿テンプレートをご利用いただき、完成原稿を PDF にてご送付ください。
講演者には予稿原稿の他に、ポスターの作成および論文原稿の執筆をお願いいたします。

- 講演申込、予稿原稿締切：
11 月 6 日(金)
- 論文 (Proceedings) 原稿締切：
12 月 16 日 (水) (シンポジウム当日)

シンポジウム申込先、
予稿集原稿、論文原稿送り先
E-MAIL : ion-sympo@ml.hosei.ac.jp

聴講でのご参加をご希望の方は、シンポジウム前日までに ion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛に申込をお願いいたします。

参加費

- 参加費 無料
- 予稿集、Proceedings 各無料 (後日郵送)

問い合わせ先

〒184-8584
東京都小金井市梶野町 3-7-2
法政大学イオンビーム工学研究所
TEL : 042-387-6094
FAX : 042-387-6095
HP : <https://www.hosei.ac.jp/ionbeam/>
E-MAIL : ion-sympo@ml.hosei.ac.jp